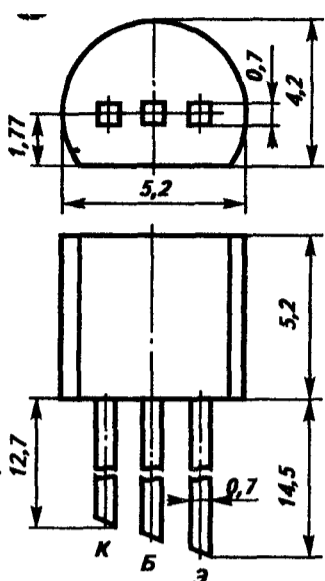
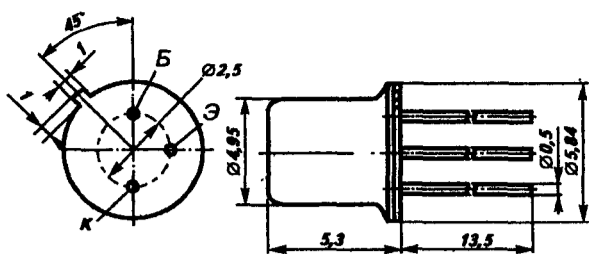


□ КТ3117А, КТ3117Б, КТ3117А1

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п, импульсные, высокочастотные. Предназначены для применения в оперативных и постоянных запоминающих устройствах. КТ3117А и КТ3117Б выпускаются в металlostеклянном корпусе, тип корпуса КТ-1-7; КТ3117А1 —



пластмассовом корпусе, тип корпуса КТ-26. Масса КТ3117А и КТ3117Б не более 0,4 г; КТ3117А1 не более 0,3 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при

$U_{кб} = 5 \text{ В}, I_э = 200 \text{ мА}, f = 50 \text{ Гц}$:

$T = +25^\circ\text{C}$ КТ3117А, КТ3117Б 40...200

КТ3117А1 100...300

$T = +85^\circ\text{C}$ КТ3117А, КТ3117Б 30...350

КТ3117А1 80...400

$T = -45^\circ\text{C}$ КТ3117А, КТ3117Б 15...200

КТ3117А1 40...300

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кб} = 10 \text{ В}, I_к = 30 \text{ мА}, f = 100 \text{ МГц}$, не менее 2

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при

$I_к = 500 \text{ мА}, I_э = 50 \text{ мА}$, не более 0,6 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при

$I_к = 500 \text{ мА}, I_э = 50 \text{ мА}$, не более 1,2 В

Время рассасывания при $I_к = 500 \text{ мА}, I_э = 50 \text{ мА}$,

$t_n = 300 \text{ мкс}, Q > 50$, не более 0,08 мкс

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 \text{ В}$,

$I_э = 0, f = 10 \text{ МГц}$, не более 10 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0 \text{ В}$,

$f = 10 \text{ МГц}$, не более 80 пФ

Обратный ток коллектора для КТ3117А и КТ3117А1

при $U_{кб} = 60 \text{ В}$, для КТ3117Б при $U_{кб} = 75 \text{ В}$, не более

$T = +25^\circ\text{C}$ 10 мкА

$T = +85^\circ\text{C}$ 100 мкА

$T = -45^\circ\text{C}$ 10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

КТ3117А, КТ3117А1 60 В

КТ3117Б 75 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер¹:

КТ3117А, КТ3117А1 60 В

КТ3117Б 75 В

Постоянное напряжение эмиттер-база²

..... 4 В

Постоянный ток коллектора

..... 400 мА

Импульсный ток коллектора³

..... 800 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора⁴

при $T = -45...+45^\circ\text{C}$ 0,3 Вт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при

$t_n < 10 \text{ мкс}$ при $T = -45...+45^\circ\text{C}$ 0,8 Вт

Температура р-п перехода $+150^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды $-45^\circ\text{C}...+85^\circ\text{C}$

¹ При $R_{эб} = 0$, при $R_{эб} = 1 \text{ кОм}$ постоянное напряжение коллектор-эмиттер равно 50 В.

² Допускается увеличение импульсного напряжения эмиттер-база до 5 В при $t_n < 10 \text{ мкс}, Q > 2$.

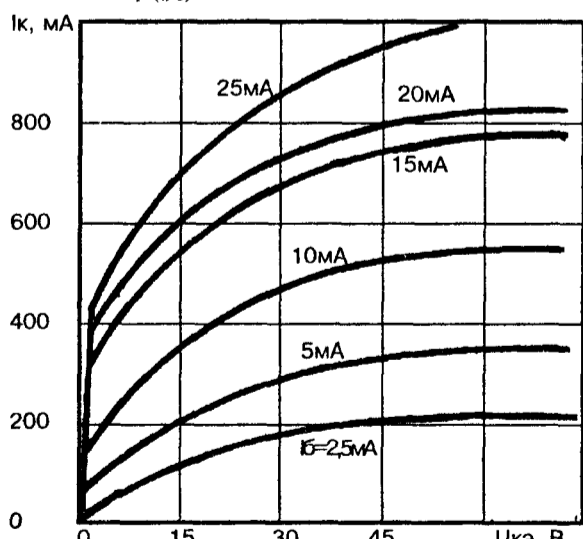
³ При $t_n < 10 \text{ мкс}$.

⁴ При $T = +40...+85^\circ\text{C}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется

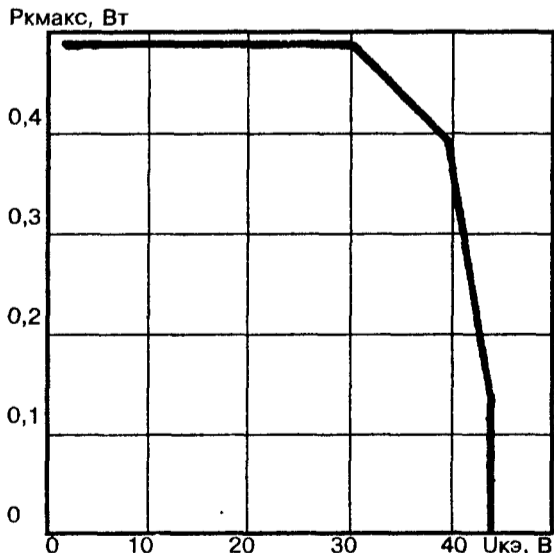
из выражения

$$P_{\text{кмакс}} = (150 - T) / R_{T(\text{п.с})}, \text{ Вт. Здесь } R_{T(\text{п.с})} = 350^\circ\text{C}/\text{Вт для КТ3117А и КТ3117Б}$$

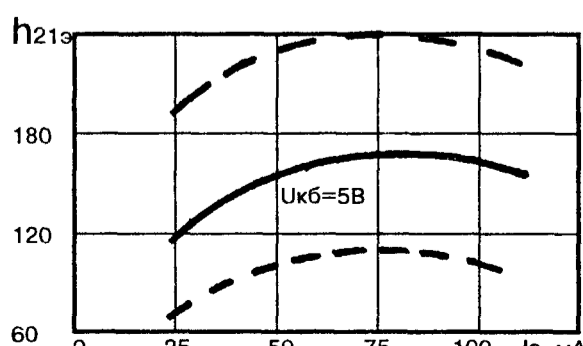
$$R_{T(\text{п.с})} = 250^\circ\text{C}/\text{Вт для КТ3117А1}$$



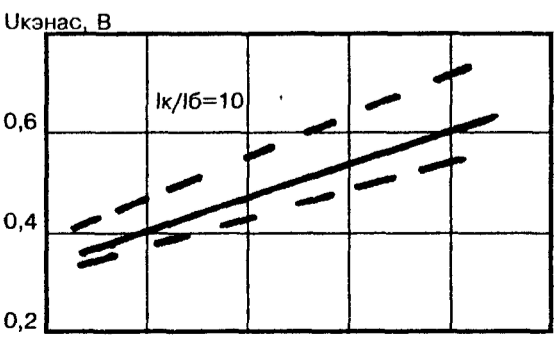
Типовые выходные характеристики в схеме ОЭ



Типовая зависимость суммарной максимально допустимой мощности коллектора от напряжения коллектор-эмиттер



Зависимость статического коэффициента передачи тока от постоянного тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора